

日程表 (会場別 I)

会場名	収容人数	2019年3月9日(土)		2019年3月10日(日)		2019年3月11日(月)		2019年3月12日(火)		
		午前	午後	午前	午後	午前	午後	午前	午後	
W1 (本館)	M101 (H101)	200	09:00 ~ 12:10 TU3 スピントロニクス入門 (高梨 弘毅)	16:00 ~ 18:00 10.1 新物質・新機能創成 (作製・評価技術)	09:00 ~ 11:15 10.1 新物質・新機能創成 (作製・評価技術)	13:30 ~ 16:45 S11 IoT/IoH時代におけるデバイス	09:00 ~ 12:00 CS9 10.1 新物質・新機能創成 (作製・評価技術), 10.2 スピン基礎技術・萌芽的デバイス技術, 10.3 スピンデバイス・磁気メモリストレージ技術, 10.4 半導体スピントロニクス・超伝導・強相関のコードシェアセッション	13:15 ~ 15:00 CS9 10.1, 10.2, 10.3 10.4のコードシェアセッション	09:00 ~ 10:30 10.3 スピンデバイス・磁気メモリストレージ技術	13:00 ~ 17:00 10.4 半導体スピントロニクス・超伝導・強相関
	M103 (H103)	96	10:00 ~ 11:30 2.3 放射線応用・発生装置・新技術	13:15 ~ 17:30 2.3 放射線応用・発生装置・新技術	09:00 ~ 10:45 8.6 Plasma Electronics English Session	13:30 ~ 16:25 S10 カーボン系材料プラズマプロセスの現状と課題		13:15 ~ 16:00 13.6 ナノ構造・量子現象・ナノ量子デバイス	09:00 ~ 11:45 2.2 検出器開発	13:15 ~ 16:15 2.2 検出器開発
	M111 (H111)	112	09:00 ~ 11:30 TU2 2次元層状物質材料の基礎と薄膜形成法 (上野 啓司)	13:30 ~ 18:35 S6 量子センシング ~ 究極の感度を求めて ~	09:00 ~ 11:45 12.1 作製・構造制御	13:30 ~ 17:40 S12 コロイド量子ドット研究の現状と展望	09:00 ~ 11:45 12.1 作製・構造制御	13:15 ~ 18:30 12.1 作製・構造制御	09:30 ~ 12:00 15.7 結晶評価, 不純物・結晶欠陥	13:30 ~ 17:00 15.7 結晶評価, 不純物・結晶欠陥
	M112 (H112)	80	09:00 ~ 12:00 6.6 プローブ顕微鏡	13:30 ~ 16:00 TU4 電気化学界面・デバイスの局所評価技術の基礎と応用 (大西 洋・高橋 康史)	10:00 ~ 11:30 2.3 放射線応用・発生装置・新技術	13:15 ~ 15:00 7.1 X線技術	09:00 ~ 12:00 12.2 評価・基礎物性	13:15 ~ 17:45 12.2 評価・基礎物性		
	M113 (H113)	75		13:30 ~ 15:30 6.2 カーボン系薄膜	10:00 ~ 11:30 6.2 カーボン系薄膜	13:15 ~ 18:00 10.5 磁場応用	09:00 ~ 11:45 6.2 カーボン系薄膜	13:15 ~ 19:00 6.2 カーボン系薄膜	09:30 ~ 11:30 15.5 IV族結晶, IV-IV族混晶	13:15 ~ 15:30 15.5 IV族結晶, IV-IV族混晶
	M114 (H114)	98	09:00 ~ 12:00 13.4 Si系プロセス・Si系薄膜・MEMS・装置技術	13:15 ~ 15:45 13.4 Si系プロセス・Si系薄膜・MEMS・装置技術	09:00 ~ 12:00 13.4 Si系プロセス・Si系薄膜・MEMS・装置技術	13:30 ~ 18:15 S4 光プロセスの基礎過程に迫る計測・モニタリング技術の進展	10:30 ~ 11:45 3.3 情報フォトニクス・画像工学	13:30 ~ 16:00 TU5 ゼロから始めるAI実験 (渡辺 英治)		
	M116 (H116)	72	09:00 ~ 11:15 3.1 光学基礎・光学新領域	13:15 ~ 17:00 3.1 光学基礎・光学新領域	09:00 ~ 11:15 3.1 光学基礎・光学新領域	13:00 ~ 19:00 9.1 誘電材料・誘電体		13:15 ~ 17:00 1.5 計測技術・計測標準	09:15 ~ 11:30 3.14 光制御デバイス・光ファイバー	13:15 ~ 16:45 3.14 光制御デバイス・光ファイバー
	M121 (H121)	240	09:30 ~ 12:30 13.7 化合物及びパワー電子デバイス・プロセス技術	14:00 ~ 17:45 13.7 化合物及びパワー電子デバイス・プロセス技術	09:00 ~ 11:45 13.7 化合物及びパワー電子デバイス・プロセス技術	13:30 ~ 16:45 S16 IoTの発展を支える集積化システム	09:00 ~ 12:15 13.7 化合物及びパワー電子デバイス・プロセス技術	13:30 ~ 17:45 S14 ナノバイオ分野での実験と計算の連携・融合: 脂質膜と膜タンパク質	09:00 ~ 11:30 13.7 化合物及びパワー電子デバイス・プロセス技術	
	M135 (H135)	112	09:00 ~ 11:30 3.6 超高速・高強度レーザー	13:15 ~ 18:00 3.6 超高速・高強度レーザー	09:00 ~ 12:00 3.6 超高速・高強度レーザー	13:30 ~ 17:15 S3 多様な光ファイバセンシング技術		13:30 ~ 19:00 S5 ナノ物質光マニピュレーションが拓く新奇現象・機能・技術		
	M136 (H136)	101		13:30 ~ 15:30 12.3 機能材料・萌芽的デバイスのコードシェアセッション	09:30 ~ 12:00 CS1 3.2 材料・機器光学, 12.3 機能材料・萌芽的デバイスのコードシェアセッション		09:00 ~ 11:45 12.3 機能材料・萌芽的デバイス	13:15 ~ 17:15 13.3 絶縁膜技術		
W2 (西2号館)	W241	255	09:00 ~ 11:30 TU1 気相からの薄膜形成の基礎→プラズマ屋の視点から (白藤 立)	13:45 ~ 17:00 8.4 プラズマサイエンス	11:00 ~ 11:30 8.7 プラズマエレクトロニクス分科内招待講演	13:30 ~ 17:15 S22 金属酸化物による新技術の開拓 I ~ 薄膜形成からデバイス創出に至るまで ~	10:00 ~ 12:00 SP7 就活生必見! 知っていますか? エレクトロニクス産業が拡大し続けていることを!	13:30 ~ 17:15 S9 計算機による物性予測と酸化物機能の開拓		
	W242	108	09:00 ~ 12:15 12.6 ナノバイオテクノロジー	13:45 ~ 17:45 12.6 ナノバイオテクノロジー	09:00 ~ 10:30 12.6 ナノバイオテクノロジー	13:00 ~ 17:45 SP6 ここが変だよ, 日本の研究環境	09:00 ~ 12:15 S21 エネルギーハーベスティングの新展開	13:45 ~ 15:15 S21 エネルギーハーベスティングの新展開		
	W321	102	09:00 ~ 12:00 23.1 合同セッション「AI/フォニクス応用」	13:45 ~ 17:45 23.1 合同セッション「AI/フォニクス応用」	09:00 ~ 11:45 23.1 合同セッション「AI/フォニクス応用」	13:15 ~ 17:30 13.9 化合物太陽電池	09:30 ~ 12:00 13.9 化合物太陽電池	13:45 ~ 17:30 13.9 化合物太陽電池		
	W323	101	09:00 ~ 12:15 6.4 薄膜新材料	13:30 ~ 18:00 8.1 プラズマ生成・診断	09:00 ~ 12:15 6.4 薄膜新材料	13:45 ~ 18:15 6.4 薄膜新材料		13:45 ~ 17:45 8.5 プラズマ現象・新応用・融合分野		
W3 (西3号館)	W331	102		13:45 ~ 16:45 3.16 Optics and Photonics English Session	09:00 ~ 11:45 CS4 3.15 シリコンフォトニクス, 3.16 Optics and Photonics English Sessionのコードシェアセッション	13:45 ~ 18:00 3.3 情報フォトニクス・画像工学	09:45 ~ 12:15 3.15 シリコンフォトニクス	13:45 ~ 17:30 3.15 シリコンフォトニクス		
	W351	102		13:45 ~ 17:00 9.4 熱電変換	10:30 ~ 12:00 9.4 熱電変換	13:45 ~ 18:00 CS8 9.4 熱電変換, 12.3 機能材料・萌芽的デバイス, 合同セッション「フォノンエンジニアリング」のコードシェアセッション	09:00 ~ 12:00 6.1 強誘電体薄膜	13:00 ~ 17:00 6.1 強誘電体薄膜		
	W371	72	09:00 ~ 10:00 16.2 エナジーハーベスティング	13:45 ~ 18:15 22.1 合同セッション「フォノンエンジニアリング」	09:00 ~ 12:15 22.1 合同セッション「フォノンエンジニアリング」					
	W521	269	09:00 ~ 12:00 SP3 異種領域融合のイノベーションを探る, 国際システムデバイス技術ロードマップ(2019)	13:45 ~ 18:00 17.2 グラフェン	09:00 ~ 12:15 17.2 グラフェン	13:45 ~ 15:45 17.2 グラフェン	09:00 ~ 10:00 17.2 グラフェン	13:45 ~ 18:30 17.3 層状物質	09:00 ~ 11:30 17.3 層状物質	
W5 (西5号館)	W541	269	09:00 ~ 12:15 15.4 III-V族窒化物結晶	13:30 ~ 18:00 S18 窒化物半導体特異構造の科学 ナノ物性評価技術の進展と物性制御	09:00 ~ 12:15 15.4 III-V族窒化物結晶	13:30 ~ 19:00 15.4 III-V族窒化物結晶	09:00 ~ 12:15 15.4 III-V族窒化物結晶	13:30 ~ 19:00 15.4 III-V族窒化物結晶	09:00 ~ 12:15 15.4 III-V族窒化物結晶	13:30 ~ 17:00 15.4 III-V族窒化物結晶
	W611	108	09:30 ~ 11:45 16.3 シリコン系太陽電池	13:30 ~ 15:45 16.3 シリコン系太陽電池	09:30 ~ 12:00 16.3 シリコン系太陽電池	13:30 ~ 17:30 16.3 シリコン系太陽電池	09:00 ~ 12:00 8.4 プラズマサイエンス	13:45 ~ 17:00 3.13 半導体光デバイス	09:00 ~ 12:00 3.13 半導体光デバイス	13:45 ~ 16:45 3.13 半導体光デバイス
	W621	143	09:00 ~ 12:15 3.12 ナノ領域光科学・近接場光学	13:30 ~ 18:15 3.12 ナノ領域光科学・近接場光学	09:00 ~ 12:30 3.12 ナノ領域光科学・近接場光学	13:45 ~ 18:30 3.12 ナノ領域光科学・近接場光学	09:30 ~ 11:45 17.1 カーボンナノチューブ, 他のナノカーボン材料	13:45 ~ 18:30 17.1 カーボンナノチューブ, 他のナノカーボン材料		
	W631	142	09:00 ~ 12:15 3.7 レーザープロセス	13:45 ~ 16:45 3.7 レーザープロセス	09:00 ~ 12:15 3.7 レーザープロセス	13:45 ~ 17:00 CS5 6.1 強誘電体薄膜, 13.3 絶縁膜技術, 13.5 デバイス/配線/集積化技術のコードシェアセッション	09:30 ~ 12:15 3.11 フォトニック構造・現象	13:45 ~ 18:30 3.11 フォトニック構造・現象	09:00 ~ 12:30 CS3 3.11 フォトニック構造・現象, 13.6 ナノ構造・量子現象・ナノ量子デバイスのコードシェアセッション	13:45 ~ 16:15 3.11 フォトニック構造・現象
	W641	142	09:00 ~ 12:15 3.4 生体・医用光学	13:45 ~ 16:15 3.4 生体・医用光学	09:00 ~ 11:45 6.3 酸化物エレクトロニクス	13:45 ~ 18:15 6.3 酸化物エレクトロニクス	09:00 ~ 11:45 6.3 酸化物エレクトロニクス	13:45 ~ 17:30 8.2 フラズマ成膜・エッチング・表面処理	09:00 ~ 12:45 8.2 フラズマ成膜・エッチング・表面処理	
	W833	78		13:30 ~ 17:55 S7 隔電子回折による表面科学の新展開と高速化データ駆動科学	09:00 ~ 11:30 16.1 基礎物性・評価・プロセス・デバイス	13:15 ~ 17:45 16.1 基礎物性・評価・プロセス・デバイス	09:00 ~ 11:45 9.2 ナノ粒子・ナノワイヤ・ナノシート	13:15 ~ 16:30 9.2 ナノ粒子・ナノワイヤ・ナノシート	10:00 ~ 12:00 1.1 応用物理一般・学際領域	13:15 ~ 15:00 1.1 応用物理一般・学際領域
W8 (西8号館)	W834	61		13:15 ~ 16:30 1.6 超音波	09:00 ~ 12:15 3.5 レーザー装置・材料	17:15 ~ 18:30 CS2 3.5 レーザー装置・材料と3.14 光制御デバイス・光ファイバーのコードシェアセッション		13:15 ~ 18:30 13.2 探索的材料物性・基礎物性	09:00 ~ 10:30 6.5 表面物理・真空	
	W810 (E1001)	100	11:00 ~ 12:00 講演奨励賞・Exhibition Award, APEX/JJAP賞貢献賞式	17:00 ~ 18:15 業績賞, 研究分野業績賞, 光学業績賞授賞式	09:15 ~ 12:00 12.2 評価・基礎物性	13:30 ~ 18:00 S13 物質に内在する学習・最適化能力を活用するマテリアル知能科学	09:00 ~ 11:45 31.1 フォーカストセッション「AIエレクトロニクス」	13:15 ~ 18:00 31.1 フォーカストセッション「AIエレクトロニクス」		

日程表 (会場別Ⅱ)

会場名	収容人数	2019年3月9日(土)		2019年3月10日(日)		2019年3月11日(月)		2019年3月12日(火)		
		午前	午後	午前	午後	午前	午後	午前	午後	
W9 (西9時開)	W922 (デジタル多目的ホール)	287	09:50 ~ 12:20 SP1 国公私大の地域を超えた役割と連携：未来社会と応用物理	13:20 ~ 17:20 SP2 研究者を幸せにする環境とはー日本の研究力を最大化するためにー	09:00 ~ 11:15 15.2 II-VI族結晶および多元系結晶	13:30 ~ 17:50 S19 イオン注入技術の進展～Si、GaAsから最先端WBG半導体まで～				
	W933	153	09:00 ~ 11:30 6.3 酸化物エレクトロニクス	13:15 ~ 17:35 S15 多元化合物材料研究の動向・趨勢～物性制御と応用展開～	09:00 ~ 11:00 6.6 フロー顕微鏡	13:30 ~ 17:45 S8 新デバイス・材料開発のためのナノスケール2次元/3次元分析(II)	09:00 ~ 11:45 6.6 フロー顕微鏡	13:30 ~ 18:45 S20 結晶工学×放射線シンボソウム	09:00 ~ 12:00 6.6 フロー顕微鏡	13:15 ~ 16:00 31.1 フォーカストセッション「AIエレクトロニクス」
	W934	81			09:00 ~ 12:00 13.1 Si系基礎物性・表面界面・シミュレーション	13:30 ~ 16:45 13.1 Si系基礎物性・表面界面・シミュレーション	09:00 ~ 11:45 13.4 Si系プロセス・Si系薄膜・MEMS・装置技術	13:30 ~ 17:45 S17 先端イオン顕微鏡技術のナノスケール材料・デバイスへの展開	09:15 ~ 11:45 9.3 ナノエレクトロニクス	13:15 ~ 16:00 9.3 ナノエレクトロニクス
	W935	90		13:15 ~ 17:15 3.8 光計測技術・機器	09:30 ~ 12:15 S1 環境・エネルギーを意識した物理教育を考える		09:00 ~ 11:45 3.8 光計測技術・機器	13:15 ~ 16:30 3.8 光計測技術・機器		
70A (創立70周年記念講堂)	700		13:00 ~ 17:30 SP4 急加速する「クルマの電動化」～電池・パワー半導体・モータシステムの協調開発～		09:00 ~ 12:00 13.1 Si系基礎物性・表面界面・シミュレーション	13:00 ~ 17:20 SP5 インフォーマティクス活用の時代	09:00 ~ 11:45 15.6 IV族系化合物 (SiC)	13:00 ~ 17:30 15.6 IV族系化合物 (SiC)		
S0 (西講義棟)	S011	153	13:45 ~ 17:15 21.1 合同セッションK「ワイドギャップ酸化物半導体材料・デバイス」	09:00 ~ 11:15 21.1 合同セッションK「ワイドギャップ酸化物半導体材料・デバイス」	13:45 ~ 16:55 S2 計測標準から見る計測・測定技術	09:00 ~ 11:30 21.1 合同セッションK「ワイドギャップ酸化物半導体材料・デバイス」	13:45 ~ 18:45 21.1 合同セッションK「ワイドギャップ酸化物半導体材料・デバイス」			
	S221	173	13:45 ~ 17:45 13.5 デバイス/配線/集積化技術	09:00 ~ 12:00 13.5 デバイス/配線/集積化技術	13:45 ~ 17:00 13.5 デバイス/配線/集積化技術	09:00 ~ 12:15 12.5 有機太陽電池	13:45 ~ 17:15 12.5 有機太陽電池	09:00 ~ 12:15 12.5 有機太陽電池		
	S222	186	09:00 ~ 12:15 12.5 有機太陽電池	13:45 ~ 17:00 12.5 有機太陽電池	09:00 ~ 12:15 12.4 有機EL・トランジスタ	13:45 ~ 18:00 12.4 有機EL・トランジスタ	09:00 ~ 12:15 12.4 有機EL・トランジスタ	13:45 ~ 17:15 12.4 有機EL・トランジスタ		
	S223	75	09:30 ~ 12:00 7.2 電子ビーム応用	13:45 ~ 17:00 7.3 微細パターン・微細構造形成技術	09:30 ~ 12:15 13.8 光物性・発光デバイス	13:45 ~ 16:45 11.5 接合、回路作製プロセスおよびデジタル応用	09:30 ~ 12:15 13.8 光物性・発光デバイス	13:45 ~ 18:00 13.8 光物性・発光デバイス		
S224	75			09:30 ~ 11:30 7.5 イオンビーム一般	13:45 ~ 18:15 11.3 臨界電流、超伝導パワー応用	10:30 ~ 12:00 CS6 6.5 表面物理・真空、7.6 原子・分子線およびビーム関連技術のコードシェアセッション	13:45 ~ 15:15 12.3 機能材料・萌芽的デバイス			
S3 (南5時開)	S321	54	13:45 ~ 18:00 1.4 エネルギー変換・貯蔵・資源・環境	09:00 ~ 12:30 1.3 新技術・複合新領域	13:45 ~ 15:45 3.2 材料・機器光学	09:00 ~ 10:15 11.2 薄膜、厚膜、テープ作製プロセスおよび結晶成長	13:45 ~ 18:30 11.4 アナログ応用および関連技術			
S4 (南4時開)	S421	102	09:00 ~ 12:15 12.7 医用工学・バイオチップ	13:45 ~ 18:00 12.7 医用工学・バイオチップ	09:00 ~ 12:15 12.7 医用工学・バイオチップ	15:45 ~ 18:15 12.7 医用工学・バイオチップ	09:00 ~ 12:15 3.9 テラヘルツ全般	13:45 ~ 18:45 3.9 テラヘルツ全般	09:00 ~ 12:00 3.9 テラヘルツ全般	
	S422	72	09:00 ~ 12:15 15.1 バルク結晶成長	13:45 ~ 18:00 15.1 バルク結晶成長		13:45 ~ 17:00 3.10 光量子物理・技術	09:30 ~ 12:15 15.3 III-V族エピタキシャル結晶・エピタキシーの基礎	13:45 ~ 17:00 15.3 III-V族エピタキシャル結晶・エピタキシーの基礎		
	S423	72		09:00 ~ 12:00 CS7 7.4 量子ビーム界面構造計測、9.5 新機能材料・新物性のコードシェアセッション	13:30 ~ 17:15 CS7 7.4 量子ビーム界面構造計測、9.5 新機能材料・新物性のコードシェアセッション	09:00 ~ 11:45 11.1 基礎物性	12:45 ~ 17:45 11.1 基礎物性			
S6 (南6時開)	S622	109				09:45 ~ 10:45 2.2 検出器開発	13:00 ~ 15:30 2.1 放射線物理一般、検出器基礎			
			10:45 ~ 11:45 2.1 放射線物理一般、検出器基礎							
会場名	収容人数	2019年3月9日(土)		2019年3月10日(日)		2019年3月11日(月)		2019年3月12日(火)		
PA (体育館)	PA1 ~ PA12	ボスターセッション	[09:30 ~ 11:30] 9.4 熱電変換 12.3 機能材料・萌芽的デバイス 22.1 合同セッションM「フォノンエンジニアリング」	[13:30 ~ 15:30] 6.4 薄膜新材料 12.4 有機EL・トランジスタ	[09:30 ~ 11:30] 3.3 情報フォニクス・画像工学 3.8 光計測技術・機器 6.1 強誘電体薄膜 9.1 誘電体・誘電体 11 超伝導	[13:30 ~ 15:30] 9.2 ナノ粒子・ナノワイヤ・ナノシート 12.6 ナノバイオテクノロジー 12.7 医用工学・バイオチップ 13.6 ナノ構造・量子現象・ナノ量子デバイス	[09:30 ~ 11:30] 3.1 光学基礎・光学新領域 3.2 材料・機器光学 3.4 生体・医用光学 3.5 レーザ・装置・材料 8.2 フラズマ成膜・エッチング・表面処理 8.3 フラズマテクノロジー 8.5 フラズマ現象・新応用・融合分野 23 合同セッションN「インフォーマティクス応用」	[13:30 ~ 15:30] 1.1 応用物理一般・学際領域 1.3 新技術・複合新領域 1.4 エネルギー変換・貯蔵・資源・環境 15.3 III-V族エピタキシャル結晶・エピタキシーの基礎 15.5 IV族結晶、IV-V族混晶 15.7 結晶評価、不純物・結晶欠陥	[09:30 ~ 11:30] 1.5 計測技術・計測標準 3.6 超高速・高強度レーザー 21.1 合同セッションK「ワイドギャップ酸化物半導体材料・デバイス」 31.1 フォーカストセッション「AIエレクトロニクス」	
PB (演習棟)	PB1 ~ PB10	ボスターセッション	[13:30 ~ 15:30] 10 スピントロニクス・マグネティクス	[13:30 ~ 15:30] 10 スピントロニクス・マグネティクス	[09:30 ~ 11:30] 12.5 有機太陽電池 13.2 探索的材料物性・基礎物性 13.9 化合物太陽電池	[13:30 ~ 15:30] 1.6 超音波 3.9 テラヘルツ全般 3.11 フォトニック構造・現象	[09:30 ~ 11:30] 13.1 Si系基礎物性・表面界面・シミュレーション 13.3 絶縁膜技術 13.5 デバイス/配線/集積化技術 15.4 III-V族化合物結晶	[13:30 ~ 15:30] 3.12 ナノ領域光科学・近接場光学 3.14 光制御デバイス・光ファイバー 13.7 化合物及びパワー電子デバイス・プロセス技術	[09:30 ~ 11:30] 8.1 フラズマ生成・診断 8.4 フラズマリアイオン 13.4 Si系プロセス・Si系薄膜・MEMS・装置技術 13.8 光物性・発光デバイス	
			[16:00 ~ 18:00] 6.2 カーボン系薄膜 6.3 酸化物エレクトロニクス 6.6 フロー顕微鏡 12.2 評価・基礎物性	[16:00 ~ 18:00] 3.7 レーザプロセス 12.1 作製・構造制御 16.1 基礎物性・評価・プロセス・デバイス 16.2 エナジーハーベスティング 16.3 シリコン系太陽電池	[16:00 ~ 18:00] 6.5 表面物理・真空 7 ビーム応用 9.5 新機能材料・新物性 17 ナノカーボン	[16:00 ~ 18:00] 3.13 半導体デバイス 17 ナノカーボン	[16:00 ~ 18:00] 2 放射線			